

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки  
Физико-технологический институт  
имени К.А. Валиева  
Российской академии наук  
(ФТИАН им. К.А. Валиева РАН)

Нахимовский пр-кт, д. 34, Москва, 117218  
тел. (499) 129-00-46, факс (499) 125-38-26  
e-mail: [lukichev@ftian.ru](mailto:lukichev@ftian.ru), [director@ftian.ru](mailto:director@ftian.ru)  
ОКПО 05818260, ОГРН 1037739352155  
ИНН/КПП 7727084140/772701001

22.10.2020 № 11619 - 6215/163

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю диссертационного  
совета Д 212.268.04  
Шандарову С.М.

Глубокоуважаемый Станислав Михайлович!

Я, Мяконьких Андрей Валерьевич, согласен выступить официальным оппонентом по диссертации Филиппова Ивана Андреевича по теме «Особенности применения плазменных технологий для формирования наноразмерных элементов плазмоники и гетероструктурных СВЧ транзисторов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.04 – Физическая электроника.

Сведения об официальном оппоненте

Фамилия, имя, отчество	Мяконьких Андрей Валерьевич
Ученая степень	к.ф.-м.н.
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация	05.27.01 -Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах
Ученое звание	нет
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический институт имени К.А. Валиева Российской академии наук (ФТИАН им. К.А. Валиева РАН)
Наименование подразделения	Лаборатория Микроструктурирования и субмикронных приборов
Занимаемая должность	Старший научный сотрудник
Почтовый адрес, телефон	117535, Москва, Нахимовский проспект, д. 36, к. 1, 8(499)1295508
Адрес электронной почты	<a href="mailto:miakonkikh@ftian.ru">miakonkikh@ftian.ru</a>

Список основных публикаций по теме диссертации в основных  
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

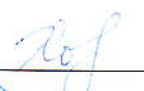
1. Rezvanov, A.A., Miakonkikh, A.V., Seregin, D.S., Vishnevskiy, A.S., Vorotilov, K.A., Rudenko, K.V., Baklanov, M.R. /Effect of terminal methyl group concentration on critical properties and plasma resistance of organosilicate low-k dielectrics /(2020) Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 38 (3), art. no. 033005. DOI: 10.1116/1.5143417
2. Zotovich A., Rezvanov A., Chanson R., Zhang L., Hacker N., Kurchikov K., Klimin S., Zyryanov S.M., Lopaev D., Gornev E., Clemente I., Miakonkikh A., Maslakov K.// Low-k protection from F radicals and VUV photons using a multilayer pore grafting approach /(2018) Journal of Physics D: Applied Physics, 51 (32), art. no. 325202. DOI: 10.1088/1361-6463/aad06d
3. Presnov D.E., Bozhev I.V., Miakonkikh A.V., Simakin S.G., Trifonov A.S., Krupenin V.A.// Local sensor based on nanowire field effect transistor from inhomogeneously doped silicon on insulator /(2018) Journal of Applied Physics, 123 (5), art. no. 054503. DOI: 10.1063/1.5019250
4. Rezvanov A., Miakonkikh A.V., Vishnevskiy A.S., Rudenko K.V., Baklanov M.R.// Cryogenic etching of porous low-k dielectrics in CF<sub>3</sub>Br and CF<sub>4</sub> plasmas / Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. 2017. V. 35. № 2. P. 021204. doi.org/10.1116/1.4975646
5. Руденко М.К., Мяконьких А.В., Лукичев В.Ф./ Моделирование методом Монте-Карло дефектов профиля тренча в процессе глубокого криогенного травления кремния/ Микроэлектроника. 2019. Т. 48. № 3. С. 191-200.
6. Мяконьких А.В., Орликовский Н.А., Рогожин А.Е., Татаринцев А.А., Руденко К.В. / Влияние дозы экспонирования на стойкость негативного электронного резиста HSQ в процессах плазмохимического и химического травления / Микроэлектроника. 2018. Т. 47. № 3. С. 179-186.
7. Куваев К.Ю., Татаринцев А.А., Орликовский Н.А., Руденко К.В., Гушин О.П., Горнев Е.С., Мяконьких А.В. / Исследование процесса сквозного плазмохимического травления hkmg стека нанотранзистора с критическим размером 32 нм / Микроэлектроника. 2018. Т. 47. № 5. С. 44-50.

«22» октября 2020 г.

 А.В. Мяконьких

Подпись Мяконьких А.В. заверяю

Ученый секретарь ФТИАН им. К.А. Валиева РАН

  
И.А. Хорин

